

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-152226

(P2017-152226A)

(43) 公開日 平成29年8月31日(2017.8.31)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/10 (2006.01)	H05B 33/10	3K107
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B	
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22 Z	
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/04	
審査請求 未請求 請求項の数 19 O L (全 17 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2016-33899 (P2016-33899)
 (22) 出願日 平成28年2月25日 (2016.2.25)

(71) 出願人 502356528
 株式会社ジャパンディスプレイ
 東京都港区西新橋三丁目7番1号
 (74) 代理人 110000408
 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
 (72) 発明者 神谷 哲仙
 東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会
 社ジャパンディスプレイ内
 Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC23 CC43 DD16
 DD17 DD89 EE48 EE49 EE50
 FF15 GG28

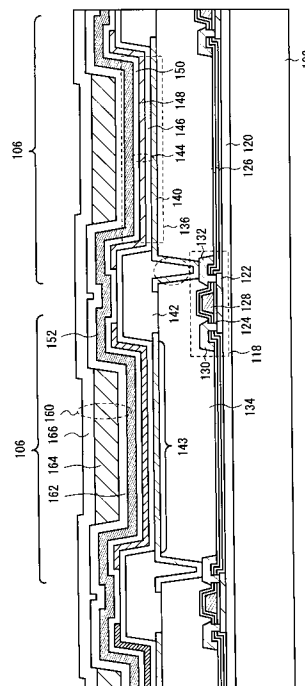
(54) 【発明の名称】 表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 高い表示品質を有する表示装置、ならびにその製造方法を提供する。

【解決手段】 第1の電極140を形成し、第1の電極の端部を覆う絶縁膜142を形成し、第1の電極と絶縁膜の上にEL層144を形成し、EL層の上に第2の電極152を形成し、無機化合物を含む第1の層162を第2の電極の上に形成し、絶縁膜とEL層と重なるように有機化合物を含む第2の層164を第1の層の上に形成し、絶縁膜と重なる領域で第1の層が露出するように第2の層を薄くし、有機化合物を含む第3の層166を第2の層の上に形成することを含む、表示装置の製造方法。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の電極を形成し、
前記第 1 の電極の端部を覆う絶縁膜を形成し、
前記第 1 の電極と前記絶縁膜の上に E L 層を形成し、
前記 E L 層の上に第 2 の電極を形成し、
無機化合物を含む第 1 の層を前記第 2 の電極の上に形成し、
前記絶縁膜と前記 E L 層と重なるように有機化合物を含む第 2 の層を前記第 1 の層の上に形成し、
前記絶縁膜と重なる領域で前記第 1 の層が露出するように第 2 の層を薄くし、
有機化合物を含む第 3 の層を前記第 2 の層の上に形成することを含む、表示装置の製造方法。

【請求項 2】

基板の上に基材を形成し、
前記基材の上に第 1 の電極を形成し、
前記第 1 の電極の端部を覆う絶縁膜を形成し、
前記第 1 の電極と前記絶縁膜の上に E L 層を形成し、
前記 E L 層の上に第 2 の電極を形成し、
無機化合物を含む第 1 の層を前記第 2 の電極の上に形成し、
前記絶縁膜と前記 E L 層と重なるように有機化合物を含む第 2 の層を前記第 1 の層の上に形成し、
前記絶縁膜と重なる領域で前記第 1 の層が露出するように第 2 の層を薄くし、
有機化合物を含む第 3 の層を前記第 2 の層の上に形成し、
前記基板を前記基材から剥離することを含む、表示装置の製造方法。

【請求項 3】

前記第 2 の層は、前記第 1 の電極の前記端部において前記絶縁膜に起因する傾斜を吸収するように形成される、請求項 1 または 2 に記載の表示装置の製造方法。

【請求項 4】

前記第 2 の層は、前記第 1 の電極と重なる領域から前記絶縁膜と重なる領域に至るまで平坦な上面を有するように形成される、請求項 1 または 2 に記載の表示装置の製造方法。

【請求項 5】

第 1 の電極、第 2 の電極、および前記第 1 の電極と前記第 2 の電極に挟持される E L 層を有する発光素子をそれぞれ有し、互いに隣接する第 1 の副画素と第 2 の副画素と、
前記第 1 の副画素と前記第 2 の副画素の間に位置し、前記第 1 の副画素と前記第 2 の副画素の前記第 1 の電極と重なる絶縁膜と、
前記第 1 の副画素と前記第 2 の副画素の前記発光素子と重なり、無機化合物を主成分とする第 1 の層と、
前記第 1 の層の上に位置し、有機化合物を主成分とする第 2 の層と、
前記第 2 の層の上に位置し、無機化合物を主成分とする第 3 の層を有し、
前記第 2 の層は前記第 1 の副画素と前記第 2 の副画素の間で分離している表示装置。

【請求項 6】

前記絶縁膜が前記第 2 の層から突き出る、請求項 5 に記載の表示装置。

【請求項 7】

前記第 1 の層と前記第 3 の層が、前記第 1 の副画素と前記第 2 の副画素にわたって連続する、請求項 5 に記載の表示装置。

【請求項 8】

前記第 2 の層が平坦な上面を有する、請求項 5 に記載の表示装置。

【請求項 9】

前記第 2 の層が、前記絶縁膜の厚さよりも小さい厚さを有する、請求項 5 に記載の表示装置。

【請求項 10】

前記絶縁膜の前記厚さが $15\ \mu\text{m}$ 以上 $50\ \mu\text{m}$ 以下であり、
前記第 2 の層の前記厚さが $1\ \mu\text{m}$ 以上 $5\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 9 に記載の表示装置。

【請求項 11】

前記無機化合物は、窒化ケイ素、酸化ケイ素、窒化酸化ケイ素、酸化窒化ケイ素から選ばれる、請求項 5 に記載の表示装置。

【請求項 12】

前記第 2 の層が樹脂を含む、請求項 5 に記載の表示装置。

【請求項 13】

第 1 の電極と、前記第 1 の電極上の EL 層と、前記 EL 層上の第 2 の電極を有する発光素子と、

前記第 1 の電極と重なる開口部を有し、前記第 1 の電極の端部を覆い、前記 EL 層の下に位置する絶縁膜と、

前記発光素子の上に位置し、無機化合物を主成分とする第 1 の層と、

前記第 1 の層の上に位置し、有機化合物を主成分とする第 2 の層と、

前記第 2 の層の上に位置し、無機化合物を主成分とする第 3 の層を有し、

前記絶縁膜と重なる領域で前記第 1 の層と前記第 3 の層が接し、

前記開口部と重なる領域で前記第 2 の層の上面が平坦である表示装置。

【請求項 14】

前記開口部において、前記第 1 の層の上面のうち前記第 1 の電極の上面と平行な面の全体が、前記第 2 の層の下面と接する、請求項 13 に記載の表示装置。

【請求項 15】

前記無機化合物は、窒化ケイ素、酸化ケイ素、窒化酸化ケイ素、酸化窒化ケイ素から選ばれる、請求項 13 に記載の表示装置。

【請求項 16】

前記第 1 の層と前記第 3 の層の少なくとも一方が窒化ケイ素を含む、請求項 13 に記載の表示装置。

【請求項 17】

前記第 2 の層が樹脂を含む、請求項 13 に記載の表示装置。

【請求項 18】

前記第 1 の電極の下に基材を有し、

前記基材は高分子を含む、請求項 13 に記載の表示装置。

【請求項 19】

前記基材が可撓性を有する、請求項 18 に記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は表示装置、例えば、EL 表示装置とその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

表示装置の代表例として、液晶素子や発光素子を各画素に有する液晶表示装置や有機 EL (Electroluminescence) 表示装置などが挙げられる。これらの表示装置は、基板上に形成された複数の画素内の各々に液晶素子あるいは有機発光素子（以下、発光素子）などの表示素子を有している。液晶素子や発光素子是一对の電極間に液晶あるいは有機化合物を含む層をそれぞれ有しており、一对の電極間に電圧を印加する、あるいは電流を供給することで駆動される。

【0003】

液晶素子と異なり発光素子では、一对の電極間に挟まれた層（以下、EL 層と記す）に含まれる有機化合物に電流が流れるため、発光素子の駆動中、有機化合物は酸化あるいは還元され、電荷を有する状態をとりうる。また、これらの活性種が再結合することによ

10

20

30

40

50

て励起状態が生じる。このような活性種は電氣的に中性の状態、あるいは基底状態と比べて反応性が高いため、他の有機化合物と反応したり、発光素子に浸入した水や酸素などの不純物と容易に反応する。反応の結果生じる生成物は発光素子の特性に影響を与え、発光素子の効率の低下や寿命の低減の原因となる。

【0004】

上述した特性劣化を抑制する方法として、発光素子上に保護膜（パッシベーション膜）を形成することが知られている。保護膜によって不純物の発光素子への侵入を防止、抑制することができるため、発光素子の特性低下や寿命の低減を防止、あるいは抑制することができる。

【先行技術文献】

10

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2014-154450号公報

【特許文献2】特開2009-266922号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は、高い表示品質を有する表示装置、例えば有機EL表示装置や可撓性有機EL表示装置を提供することを目的の一つとする。あるいは、上記表示装置の製造方法を提供することを目的の一つとする。

20

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の一実施形態は、第1の電極を形成し、第1の電極の端部を覆う絶縁膜を形成し、第1の電極と絶縁膜の上にEL層を形成し、EL層の上に第2の電極を形成し、無機化合物を含む第1の層を第2の電極の上に形成し、絶縁膜とEL層と重なるように有機化合物を含む第2の層を第1の層の上に形成し、絶縁膜と重なる領域で第1の層が露出するように第2の層を薄くし、有機化合物を含む第3の層を第2の層の上に形成することを含む、表示装置の製造方法である。

【0008】

本発明の一実施形態は、基板の上に基材を形成し、基材の上に第1の電極を形成し、第1の電極の端部を覆う絶縁膜を形成し、第1の電極と絶縁膜の上にEL層を形成し、EL層の上に第2の電極を形成し、無機化合物を含む第1の層を第2の電極の上に形成し、絶縁膜とEL層と重なるように、有機化合物を含む第2の層を第1の層の上に形成し、絶縁膜と重なる領域で第1の層が露出するように、第2の層を薄くし、有機化合物を含む第3の層を第2の層の上に形成し、基板を基材から剥離することを含む、表示装置の製造方法である。

30

【0009】

本発明の一実施形態は表示装置である。表示装置は互いに隣接する第1の副画素と第2の副画素を有し、第1の副画素と第2の副画素はそれぞれ発光素子を有する。第1の副画素と第2の副画素の発光素子は、第1の電極、第2の電極、および第1の電極と第2の電極に挟持されるEL層を有する。表示装置はさらに、第1の副画素と第2の副画素の間に位置し、第1の副画素と第2の副画素の第1の電極と重なる絶縁膜を有する。表示装置はまた、第1の副画素と第2の副画素の発光素子と重なり、無機化合物を主成分とする第1の層と、第1の層の上に位置し、有機化合物を主成分とする第2の層と、第2の層の上に位置し、無機化合物を主成分とする第3の層を有する。第2の層は第1の副画素と第2の副画素の間で分断される。

40

【0010】

本発明の一実施形態は表示装置である。表示装置は、第1の電極、第1の電極上のEL層、およびEL層上の第2の電極を有する発光素子を有する。表示装置はさらに、第1の電極と重なる開口部を有し、第1の電極の端部を覆い、EL層の下に位置する絶縁膜を有

50

する。表示装置はまた、発光素子の上の無機化合物を主成分とする第１の層と、第１の層の上に位置し、有機化合物を主成分とする第２の層と、第２の層の上に位置し、無機化合物を主成分とする第３の層を有する。第１の層と第３の層は絶縁膜と重なる領域で互いに接する。開口部と重なる領域で第２の層の上面は平坦である

【図面の簡単な説明】

【００１１】

【図１】一実施形態に係る表示装置の上面模式図。

【図２】一実施形態に係る表示装置の断面模式図。

【図３】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【図４】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

10

【図５】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【図６】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【図７】表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【図８】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【図９】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【図１０】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【図１１】一実施形態に係る表示装置の製造方法を示す断面模式図。

【発明を実施するための形態】

【００１２】

以下、本発明の各実施形態について、図面等を参照しつつ説明する。但し、本発明は、その要旨を逸脱しない範囲において様々な態様で実施することができ、以下に例示する実施形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

20

【００１３】

図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。本明細書と各図において、既出の図に関して説明したものと同様の機能を備えた要素には、同一の符号を付して、重複する説明を省略することがある。

【００１４】

本発明において、ある一つの膜を加工して複数の膜を形成した場合、これら複数の膜は異なる機能、役割を有することがある。しかしながら、これら複数の膜は同一の工程で同一層として形成された膜に由来し、同一の層構造、同一の材料を有する。したがって、これら複数の膜は同一層に存在しているものと定義する。

30

【００１５】

（第１実施形態）

本実施形態では、本発明の一実施形態に係る表示装置を図１乃至図９を用いて説明する。

。

【００１６】

[１．表示装置の構造]

本実施形態に係る表示装置１００の上面図を図１に示す。表示装置１００は、複数の画素１０８を備えた表示領域１０４、およびゲート側駆動回路（以下、駆動回路）１１０を基材１０２の一方の面（上面）に有している。一つの画素１０８に含まれる複数の副画素１０６は、互いに発光色の異なる発光素子を設けることができ、これにより、フルカラー表示を行うことができる。例えば赤色、緑色、あるいは青色で発光する発光素子を三つの副画素１０６にそれぞれ設けることができる。あるいは、全ての副画素１０６で白色発光素子を用い、カラーフィルタを用いて副画素１０６ごとに赤色、緑色、あるいは青色を取り出してフルカラー表示を行ってもよい。最終的に取り出される色は赤色、緑色、青色の組み合わせには限られない。例えば一つの画素１０８に四つの副画素１０６が含まれるように構成し、四つの副画素１０６から赤色、緑色、青色、白色の４種類の色を取り出すこともできる。

40

【００１７】

50

図1では副画素106は長方形の形状を有するように描かれているが、本発明の実施形態はこれに限られることは無く、副画素の形状は正方形や多角形でも良い。また、画素108も長方形の領域を有しているが、一つの画素108が正方形の形状を有していてもよい。副画素106の配列にも制限はなく、ストライプ配列、デルタ配列、ペントイル配列などを採用することができる。

【0018】

表示領域104から配線112が基材102の側面(図1中、表示装置100の短辺)に向かって伸びており、配線112は基材102の端部で露出され、露出部は端子114を形成する。端子114はフレキシブルプリント回路(FPC)などのコネクタ(図示せず)と接続される。配線112を介して表示領域104はICチップ116とも電氣的に接続される。これにより、外部回路(図示せず)から供給された映像信号が駆動回路110、ICチップ116を介して副画素106に与えられて副画素106の発光が制御され、映像が表示領域104上に再現される。なお図示していないが、表示装置100はICチップ116の替わりにソース側駆動回路を表示領域104の周辺に有していてもよい。本実施形態では駆動回路110は表示領域104を挟むように二つ設けられているが、駆動回路110は一つでもよい。また、駆動回路110を基材102上に設けず、異なる基板上に設けられた駆動回路をコネクタ上に形成してもよい。

【0019】

図2に表示装置100の断面模式図を示す。図2は表示領域104内に設けられる二つの副画素106を図示した断面模式図である。各副画素106内にはトランジスタ118が基材102上に設けられ、発光素子136がトランジスタ118と電氣的に接続されている。より具体的には、基材102上にアンダーコート120が設けられ、その上にトランジスタ118が備えられている。トランジスタ118は半導体膜122、ゲート絶縁膜124、ゲート128、層間膜126、ソース130、ドレイン132を有している。図2では各副画素106は一つのトランジスタ118を有するように描かれているが、各副画素106は複数のトランジスタを有していてもよく、トランジスタ以外の素子、例えば容量素子などを有していてもよい。図2に示すトランジスタ118はトップゲート構造を有するが、トランジスタ118の構造に制限はなく、ボトムゲート構造を有していてもよい。また、トランジスタ118の極性にも制限はなく、トランジスタ118はNチャネル型、Pチャネル型、いずれの極性を有していてもよい。

【0020】

トランジスタ118上には絶縁膜である平坦化膜134が設けられ、平坦化膜134に設けられた開口部(図2中、点線の楕円で囲った領域)において発光素子136の第1の電極140とトランジスタ118が電氣的に接続される。

【0021】

第1の電極140の端部と平坦化膜134の開口部は絶縁膜(以下、隔壁と記す)142で覆われている。図示しないが、隔壁142は第1の電極140の周囲の端部を覆っている。したがって、隔壁142は開口部143を有する絶縁膜であり、その開口部143が第1の電極と重なっていることになる。

【0022】

第1の電極140と隔壁142の上にはEL層144が形成され、その上に第2の電極152が設けられている。本明細書と請求項では、EL層とは一対の電極間に設けられた層を意味し、有機化合物を含む層が一つ、あるいは複数で構成され、一対の電極から注入されたホールと電子の再結合を担う層である。図2では、EL層144は第1の有機層146、第2の有機層148、第3の有機層150で構成される例が示されているが、四つ以上の有機層を用いてEL層144を構成してもよい。

【0023】

第1の有機層146と第3の有機層150は隣接する副画素106にわたって形成されており、隔壁142上でも連続している。これに対して第2の有機層148は隣接する副画素106間で分離されている。第1の有機層146と第3の有機層150は例えば第1

10

20

30

40

50

の電極 140 と第 2 の電極 152 から注入されるキャリア（ホール、電子）を第 2 の有機層 148 へ輸送する機能を有している。一方第 2 の有機層 148 ではホールと電子の再結合が生じ、これによって形成される励起状態からの発光が得られる。構造、あるいは材料が隣接する副画素 106 間で異なるように第 2 の有機層 148 を構成することで、隣接する副画素 106 間で異なる発光色を得ることができる。なお、第 2 の有機層 148 も隣接する副画素 106 と共有されるように形成し、隣接する副画素 106 で同一の素子構造を持つようにしてもよい。この場合、例えば第 2 の有機層 148 から白色の発光が得られるように形成することができ、異なる吸収特性を有するカラーフィルタを隣接する副画素 106 に設けることで、これらの副画素 106 から異なる色の発光を取り出すことができる。

10

【0024】

第 2 の電極 152 上にはパッシベーション膜 160 が設けられている。パッシベーション膜 160 は第 1 の層 162、第 2 の層 164、第 3 の層 166 を有する。

【0025】

第 1 の層 162 は好ましくは無機化合物を含み、無機化合物はケイ素を含有することが好ましい。無機化合物は例えば酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸化窒化ケイ素、窒化酸化ケイ素などから選択される。図 2 に示すように、第 1 の層 162 は第 2 の電極 152 と接しており、隣接する副画素 106 にわたって連続するように形成することができる。第 1 の層 162 は隔壁 142 に起因して面内で傾斜（あるいは凹凸）を有しており、凸部は隔壁 142 と重なり、凹部は二つの凸部の間に位置する。

20

【0026】

第 2 の層 164 は第 1 の層 162 の上に設けられ、好ましくは有機化合物を含む。有機化合物の例として樹脂に代表される高分子材料が挙げられる。高分子材料は直鎖構造でもよく、あるいは架橋して三次元ネットワークを形成した状態でもよい。高分子材料としてはエポキシ樹脂やアクリル樹脂、ポリイミド、ポリアミド、ポリカーボナート、ポリシロキサンなどが挙げられる。好ましくは第 2 の層 164 は可視光に対する透過性が高い材料を含む。

【0027】

図 2 に示すように第 2 の層 164 は隔壁 142 上で非連続であり、隣接する副画素 106 間で分離している。第 2 の層 164 の上面は、隔壁 142 の開口部 143 と重なる領域において平坦であることが好ましい。また、第 1 の層 162 の凹部において、第 1 の層 162 の上面のうち第 1 の電極 140 の上面と平行な部分の全体が、前記第 2 の層の下面と接することが好ましい。これにより、隔壁 142 と重なる領域において、第 1 の層 162 と第 3 の層 166 は接することができる。

30

【0028】

上述したように、第 2 の層 164 を形成する好ましい材料は有機化合物である。有機化合物は無機化合物と比較して水を吸収しやすく、外部から水が侵入した場合、第 2 の層は水を輸送する層として働く。しかしながら、隣接する副画素 106 間で第 2 の層 164 を分離することによって水の輸送ルートが分断されるため、一つの副画素 106 に水が侵入した場合でも、隣接する副画素へ水が伝搬されにくい。その結果、外部からの水の侵入による影響を最小限に抑制することができる。

40

【0029】

また、上面が平坦な第 2 の層 164 を設けることにより、高い平坦性を有する第 3 の層 166 を形成することができる。したがって、第 3 の層 166 が副画素 106 間で分断されることなく表示領域 104 を覆うことができ、外部から副画素 106 への水の侵入を効果的に防止することができる。

【0030】

第 2 の層 164 の厚さは隔壁 142 の厚さよりも小さくてもよい。図示しないが、隔壁 142 は第 2 の層 164 から突き出るように形成してもよい。

【0031】

50

第3の層166は第2の層164の上に設けられる。第3の層166は、第1の層で使用可能な材料、適用可能な方法で形成することができる。第1の層162と第3の層166は同じ材料を含むこともできる。好ましくは第1の層162と第3の層166の少なくとも一方が窒化ケイ素を含む。図2に示すように、第3の層166は隣接する副画素106にわたって連続するように形成してもよい。

【0032】

[2. 表示装置の製造方法]

上述した構造を有する表示装置100の製造方法を図3乃至図6に示す。図3(A)に示すように、まず基材102上にアンダーコート120を介してトランジスタ118を形成する。

【0033】

基材102は表示領域104や駆動回路110などを支持する機能を有する。このため、表示領域104や駆動回路110などを支持する物理的強度と、基材102上の素子(トランジスタ118や発光素子136など)を形成するためのプロセスの温度に対する耐熱性、プロセスで使用される薬品に対する化学的安定性があればいかなる材料を使用してもよい。具体的には基材102は、ガラスや石英、プラスチック、金属、セラミックなどを含むことができる。表示装置100に可撓性を付与する場合には、プラスチックを含む材料を用いることができ、例えばポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネートのような高分子材料を使用することができる。

【0034】

アンダーコート120は基材102から不純物が半導体膜122などへ拡散することを防ぐ機能を有する膜であり、窒化ケイ素や酸化ケイ素、窒化酸化ケイ素、酸化窒化ケイ素などの無機化合物を用い、化学気相成長法(CVD法)やスパッタリング法などを適用して形成することができる。

【0035】

アンダーコート120上には半導体膜122が形成される。半導体膜122は、半導体特性を示す材料、例えばシリコンやゲルマニウム、あるいは酸化物半導体などを用い、CVD法やスパッタリング法などを利用して形成すればよい。半導体膜122の結晶性に関しても特に限定はなく、単結晶、多結晶、微結晶、アモルファスなどのモルフォロジーを有することができる。

【0036】

次に半導体膜122上にゲート絶縁膜124を形成し、その上にゲート128を形成する。ゲート絶縁膜124もアンダーコート120と同様の材料、形成方法を用いて形成することができ、酸化ケイ素を含むことが好ましい。アンダーコート120、ゲート絶縁膜124はいずれも単層構造を有していても良く、複数の層を含有する積層構造を有していてもよい。図3(A)ではアンダーコート120、ゲート絶縁膜はともに単層の構造を有するように描かれている。ゲート128はチタンやアルミニウム、銅、モリブデン、タングステン、タンタルなどの金属やその合金などを単層、あるいは積層構造で形成することができる。例えばアルミニウムや銅などの高い導電性を有する金属を、チタンやモリブデンなどの高融点金属で挟持した積層構造を採用することができる。ゲート128の形成方法としては、スパッタリング法、CVD法、あるいは印刷法などが挙げられる。

【0037】

ゲート128を形成した後、層間膜126を形成する。層間膜126はアンダーコート120と同様の材料、形成方法を用いて形成することができ、窒化ケイ素を含有することが好ましい。層間膜126は単層構造を有していてもよく、図2に示すように、複数の層で構成されていてもよい。例えば窒化ケイ素を含む膜と酸化ケイ素を含む膜を積層して層間膜126を形成することができる。

【0038】

次にソース130、ドレイン132を形成する。これらはゲート128で使用可能な材料を用い、CVD法やスパッタリング法によって形成することができる。

10

20

30

40

50

【0039】

次にソース130、ドレイン132を覆うように平坦化膜134を形成する(図3(B))。平坦化膜134はエポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリシロキサンなどの高分子材料を含むことが好ましい。平坦化膜134はスピンコート法、インクジェット法、ラミネート法、印刷法、ディップコーティング法などの湿式成膜法を用いて形成することができる。平坦化膜134の形成により、トランジスタ118に起因する凹凸が吸収され、平坦な表面を与えることができる。

【0040】

平坦化膜134にドレイン132に達する開口部を形成し、ドレイン132と接するように第1の電極140を形成する(図3(B))。これにより、第1の電極140とトランジスタ118が電氣的に接続される。図3(B)では第1の電極140とドレイン132が直接接しているが、第1の電極140とドレイン132の間に、導電性を有する層を設けてもよい。

【0041】

発光素子136からの発光を基材102から取り出す場合には、可視光を透過できるように、例えば透光性を有する酸化物を用いて第1の電極140を形成すればよい。透光性を有する酸化物としては、インジウムスズ酸化物(ITO)、インジウム亜鉛酸化物(IZO)などが挙げられる。形成方法としてはスパッタリング法が挙げられる。一方、発光素子136からの発光を基材102とは反対の方向に取り出す場合には、可視光を反射できるように、反射率の高い金属を第1の電極140に用いることができる。具体的には、銀やアルミニウムなどが挙げられる。あるいは反射率の高い金属の上に透光性を有する酸化物を積層してもよい。

【0042】

次に隔壁142を形成する(図4(A))。隔壁142は、平坦化膜134で使用可能な材料を用い、上述した湿式成膜法を適用して基材102上の全体に形成し、その後第1の電極140の一部を露出する開口部143を形成することで作製することができる。これにより、隔壁142は第1の電極140の端部を覆うことができる。好ましくは、平坦化膜134と隔壁142は同じ材料を含有するように形成する。隔壁142の幅(隣接する副画素106間の間隔に相当する)は15 μ m以上50 μ m以下、あるいは20 μ m以上40 μ m以下であり、典型的には約30 μ mである。隔壁142の厚さは0.2 μ m以上3 μ m以下、あるいは0.5 μ m以上2 μ mであり、典型的には約1 μ mである。

【0043】

次にEL層144、第2の電極152を形成する(図4(A))。上述したように、EL層144は隣接する副画素106間で同じ構造を有していてもよく、あるいは図4(A)に示すように、隣接する副画素106で一部の層が異なってもよい。図2で示した例では、EL層144は三つの層(第1の有機層146、第2の有機層148、第3の有機層150)を有しており、第2の有機層148が隣接する副画素106間で異なっている。EL層144に含まれる各層は、乾式成膜法である蒸着法や、上述した湿式成膜法を適用して作製することができる。第2の電極152の形成は、第1の電極140と同様の材料、方法を用いて行うことができる。発光素子136からの発光を基材102側から得る場合には、反射率の高い金属やその合金などを第2の電極152に用いればよい。一方、発光素子136からの発光を基材102とは反対の方向に取り出す場合には、ITOやIZOなどの透光性を有する酸化物を用いればよい。

【0044】

次に発光素子136を保護するパッシベーション膜160を形成する(図4(B))。具体的には、まず第1の層162を第2の電極152上に形成する。したがって、第1の層162と第2の電極152は接することができる。第1の層162は、例えば窒化ケイ素や酸化ケイ素、窒化酸化ケイ素、酸化窒化ケイ素などの無機化合物を含むことができ、CVD法やスパッタリング法を適用して形成することができる。図4(B)に示すように、第1の層162は基材102全体にわたって形成することができる。したがって、隣接

する副画素 106 間で連続した構造を持つことができ、隔壁 142 と重なることになる。

【0045】

次に第 2 の層 164 を第 1 の層 162 の上に形成する（図 5）。第 2 の層 164 はエポキシ樹脂やアクリル樹脂、ポリイミド、ポリエステル、ポリカーボナートなどの高分子材料を含むことができる。第 2 の層 164 は、上述した湿式成膜法によって形成することができる。あるいは、上記高分子材料の原料となるオリゴマーを減圧下で霧状あるいはガス状にし、これを基材 102 上に吹き付けて、その後オリゴマーを重合することによって形成してもよい。この時、オリゴマー中に重合開始剤が混合されていてもよい。また、基材 102 を冷却しながらオリゴマーを基材 102 に吹き付けてもよい。

【0046】

図 5 に示すように、隔壁 142 に起因して EL 層 144 や第 2 の電極 152、第 1 の層 162 に生じる傾斜（凹凸）を吸収するように第 2 の層 164 を形成することが好ましい。すなわち、第 1 の層 162 の面内の傾斜を吸収し、平坦な上面を持つように第 2 の層 164 を形成することが好ましい。第 2 の層 164 は 1 μm 以上の厚さを有することが好ましく、例えば厚さは 1 μm 以上 5 μm 以下、あるいは 1.1 μm 以上 3 μm である。これにより第 2 の層 164 は、隔壁 142 と重なる領域において第 1 の層 162 を覆い、第 1 の電極 140 と重なる領域から隔壁 142 と重なる領域にわたって、連続した平坦な上面を有することができる。

【0047】

なお第 2 の層 164 は、隔壁 142 と重なる領域において第 1 の層 162 を完全に覆わず、第 1 の層 162 が隔壁上で露出するように形成してもよい。この場合、第 1 の層 162 の凹部において均一な厚さを有するように、あるいは第 2 の層 164 の上面全体が実質的に平坦になるような厚さを有するように、第 2 の層 164 を形成することが好ましい。

【0048】

次に第 2 の層 164 を薄くして厚さを減少させる。（図 6（A））。具体的には、第 2 の層 164 に対してプラズマ処理を行い、その厚さを減少させる。プラズマ処理は酸素を含有するガス、例えば酸素ガス、一酸化窒素、二酸化窒素などのガスの存在下で行うことができる。これにより、隔壁 142 と重なる領域において第 1 の層 162 が露出し、第 2 の層 164 は隣接する副画素 106 間で分断される。隔壁 142 の開口部 143 と重なる領域において、第 2 の層 164 は平坦な上面を与える。第 1 の層 162 の凹部において、第 1 の層 162 の上面のうち第 1 の電極 140 の上面と平行な部分の全体が、第 3 の層 166 の下面と接する。

【0049】

なお第 2 の層 164 を、隔壁 142 と重なる領域において第 1 の層 162 を完全に覆わず、第 1 の層 162 が隔壁上で露出するように形成する場合、プラズマ処理を省略することができる。

【0050】

次に第 2 の層 164 の上に第 3 の層 166 を形成する（図 6（B））。第 3 の層 166 は第 1 の層 162 で使用可能な材料を含むことができ、第 1 の層 162 と同様の方法で形成することができる。これにより、隔壁 142 と重なる領域において、第 1 の層 162 と第 3 の層 166 は互いに接する。また、第 2 の層 164 と第 3 の層 166 が接する界面は平坦であり、かつ、隣接する副画素 106 間で互いに離れることになる。すなわち、隔壁 142 と重なる領域では第 2 の層 164 と第 3 の層 166 は接しない。

【0051】

なお、第 2 の層 164 が可視光に対して高い透明性を有する場合、第 2 の層 164 の厚さを減少させることなく、第 3 の層 166 を形成してもよい。

【0052】

以上の段階を経ることで、本実施形態に係る表示装置 100 を製造することができる。図示しないが、任意の構成として、さらにカラーフィルタや遮光膜、基材 102 に対向する基板（対向基板）などをパッシベーション膜 160 の上に設けてもよい。対向基板を設

10

20

30

40

50

ける場合、基材 102 と対向基板の間に充填剤として有機樹脂を充填してもよく、あるいは不活性ガスを充填してもよい。

【0053】

上述したように、隔壁 142 に起因する傾斜（凹凸）を吸収できるよう、比較的大きな膜厚を有するように第 2 の層 164 を形成し、その後第 2 の層 164 の膜厚を減少させることで、隔壁 142 の開口部 143 と重なる領域において、第 1 の層 162、第 2 の層 164、第 3 の層 166 はいずれも、略均一な膜厚を有することができる。発光素子 136 の発光領域は第 1 の電極 140 と EL 層 144 が直接接する領域であり、これは隔壁 142 の開口部 143 と略一致する。このため、発光素子 136 の発光領域の略全体にわたり、第 1 の層 162、第 2 の層 164、第 3 の層 166 はいずれも、略均一な膜厚を有することができる。その結果、各副画素 106 の発光領域においてパッシベーション膜 160 の光学距離が均一となり、各副画素 106 内で均一な光学特性が得られる。

10

【0054】

発光素子 136 で得られる発光を第 2 の電極 152 を通して取り出す場合、パッシベーション膜 160 の光学特性が副画素 106 内で不均一な場合、副画素 106 の発光にムラが生じる。これに対し、上述した製造方法を採用することにより、各副画素 106 内で均一な光学特性を得ることができ、副画素 106 の発光のムラを抑制し、表示品質の高い映像を提供することができる。

【0055】

これに対し、第 2 の層 164 の膜厚を減少させるという本実施形態の製造方法を用いずに、比較的小さな膜厚で第 2 の層 164 を形成した場合、第 2 の層 164 は発光領域において不均一な膜厚を有しやすい。具体的には図 7（A）に示した右側の副画素 106 __ 1 のように、第 2 の層 164 の形成に用いる材料の表面張力や第 1 の層 162 に対する低い親和性に起因し、第 2 の層 164 の形成に用いる材料は第 1 の層 162 の側壁に近い領域に凝集しやすい。すなわち、所謂コーヒーカップ現象が生じる。このような状態で材料が重合、あるいは硬化した場合、第 2 の層 164 は第 1 の層 162 の側壁付近に局在化して形成され、発光領域において均一な厚さを得ることができない。

20

【0056】

この状態でさらに第 3 の層 166 を形成した場合、局在化した第 2 の層 164 の形状が維持された状態で、第 3 の層 166 が第 2 の層 164 を覆う（図 7（B））。図 7（B）に示すように、副画素 106 __ 1 内で第 2 の層 164 の厚さが大きい部分（a）と小さい部分（b）が形成される。その結果、副画素 106 __ 1 内で光学特性が不均一となって発光にムラが生じ、再現される映像の品質が低下する。

30

【0057】

さらに、表示装置 100 の製造中に発生した異物が副画素 106 に堆積した場合に対しても本実施形態の製造方法は効果的である。例えば第 1 の層 162 の上に異物 170 が堆積した場合を想定すると、図 7（A）の画素 106 __ 2 に示すように、コーヒーカップ現象によって異物 170 付近にも第 2 の層 164 の形成に用いる材料が局在化する。材料が硬化、あるいは重合するとこの形状が維持され、図 7（B）に示すように、副画素 106 __ 1 内で第 2 の層 164 の厚さが大きい部分（c）と小さい部分（d）が形成される。その結果、副画素 106 __ 1 内で光学特性が不均一となって発光にムラが生じ、再現される映像の品質が低下する。

40

【0058】

これに対して本実施形態の製造方法を用いた場合、第 2 の層 164 の形成時にコーヒーカップ現象が生じない。このため、異物 170 の全体を埋めるように、かつ平坦な上面を有するように第 2 の層 164 を形成することができる（図 8（A））。その後第 2 の層 164 の厚さを減少させても、発光領域において略均一な厚さが維持される（図 8（B））。したがって、図 9 に示すように、例えば副画素 106 __ 2 の端部に近い領域（e）、端部と異物 170 の間の領域（f）の両方で同様な光学特性が得られ、発光のムラが発生しにくい。その結果、たとえ異物 170 が副画素 106 上に残存しても、高い表示品質を維

50

持することができる。

【0059】

(第2実施形態)

本実施形態では、第1実施形態と異なる表示装置の製造方法に関し、図10、11を用いて説明する。本実施形態では、可撓性を有する表示装置200を製造する方法について記述する。第1実施形態と同様の構成については記述を省略することがある。

【0060】

まず基板180上に基材102を形成する(図10(A))。基板180は、基材102および基材102の上に形成される各素子を保持する機能を有し、そのための物理的強度、および各素子を形成するプロセスに対する耐熱性と化学的安定性を有する材料を基板180として用いることができる。具体的には、ガラスや石英、プラスチック、金属、セラミックなどを用いることができる。好ましくは後述する光照射プロセスで用いる光を透過する材料を用いる。基板180は支持基板とも呼ばれる。

10

【0061】

基材102は第1実施形態で述べたものと同様の材料を含むことができ、上述した湿式成膜法によって形成することができる。なお、可撓性の表示装置を製造するため、基材102は単独で可撓性を有する程度の厚さで形成する。

【0062】

基材102上には、第1実施形態と同様に、トランジスタ118、平坦化膜134、発光素子136、およびパッシベーション膜160が形成される(図10(A))。任意の構成として、パッシベーション膜160の上にカラーフィルタや遮光膜、あるいは封止のためのフィルムや基板を形成してもよい。

20

【0063】

その後、レーザー光源やフラッシュライトなどを利用して基材102に対して光を照射する。これにより、基材102と基板180間の接着性を低下させることができる。好ましくは基板180側から光を照射する。

【0064】

その後図10(B)の矢印で示した界面、すなわち基材102と基板180の界面に沿って基板180を分離し、図11に示す本発明の一実施形態である表示装置200を得ることができる。

30

【0065】

本実施形態の表示装置200も、第1実施形態で示したパッシベーション膜160を有する。したがって、各副画素106内で均一な光学特性を得ることができ、副画素106の発光のムラを抑制し、表示品質の高い映像を提供することができる。

【0066】

本発明の実施形態として上述した各実施形態は、相互に矛盾しない限りにおいて、適宜組み合わせる実施することができる。また、各実施形態の表示装置を基にして、当業者が適宜構成要素の追加、削除もしくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略もしくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。

40

【0067】

本明細書においては、開示例として主にEL表示装置の場合を例示したが、他の適用例として、その他の自発光型表示装置、液晶表示装置、あるいは電気泳動素子などを有する電子ペーパー型表示装置など、あらゆるフラットパネル型の表示装置が挙げられる。また、中小型から大型まで、特に限定することなく適用が可能である。

【0068】

上述した各実施形態の態様によりもたらされる作用効果とは異なる他の作用効果であっても、本明細書の記載から明らかなもの、又は、当業者において容易に予測し得るものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。

【符号の説明】

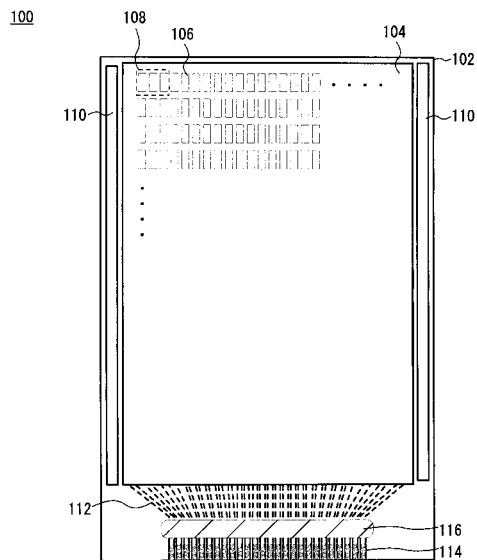
50

【0069】

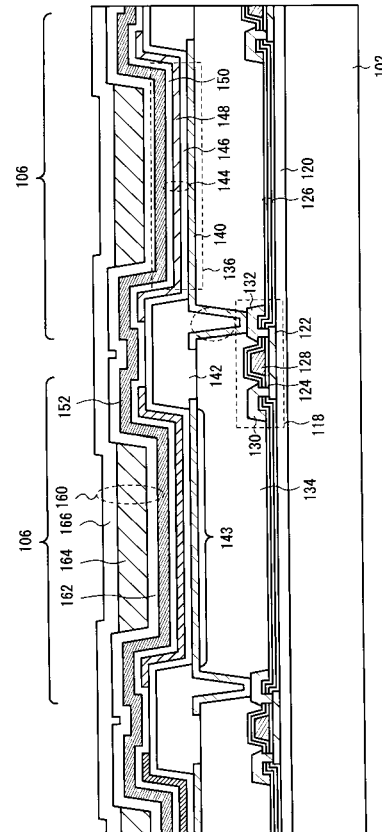
100：表示装置、102：基材、104：表示領域、106：副画素、106_1：副画素、106_2：副画素、108：画素、110：駆動回路、112：配線、114：端子、116：チップ、118：トランジスタ、120：アンダーコート、122：半導体膜、124：ゲート絶縁膜、126：層間膜、128：ゲート、130：ソース、132：ドレイン、134：平坦化膜、136：発光素子、140：第1の電極、142：隔壁、143：開口部、144：EL層、146：第1の有機層、148：第2の有機層、150：第3の有機層、152：第2の電極、160：パッシベーション膜、162：第1の層、164：第2の層、166：第3の層、170：異物、180：基板、200：表示装置

10

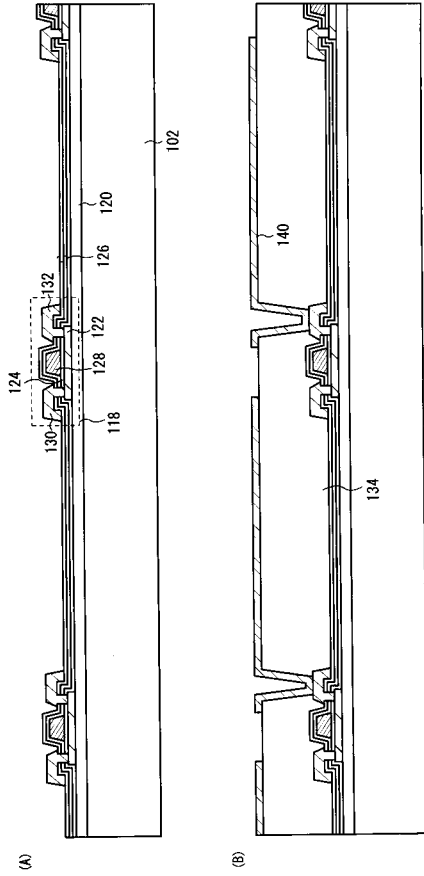
【図1】



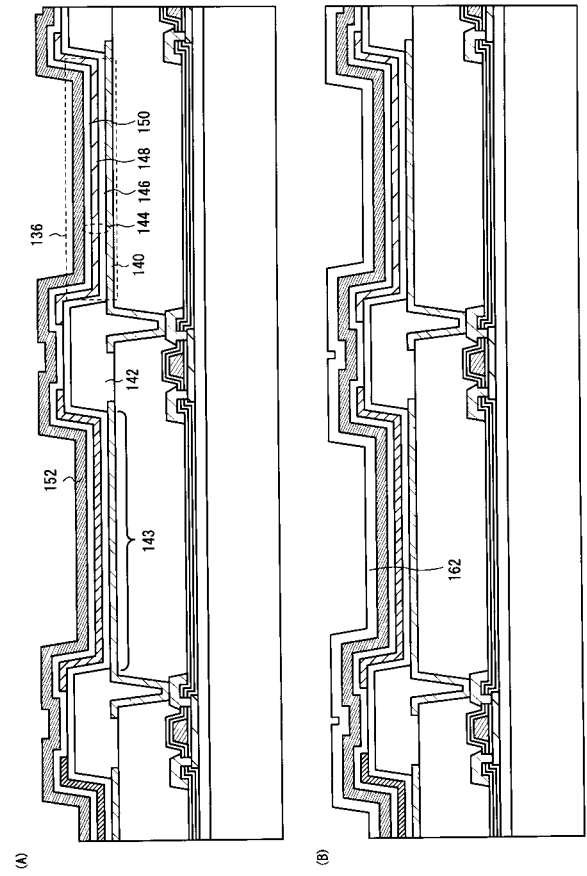
【図2】



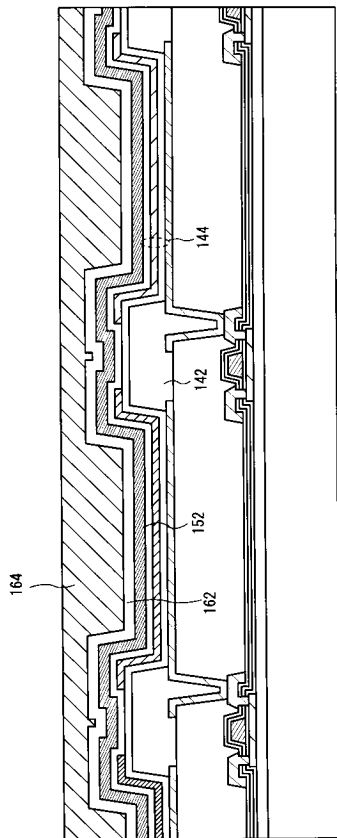
【図 3】



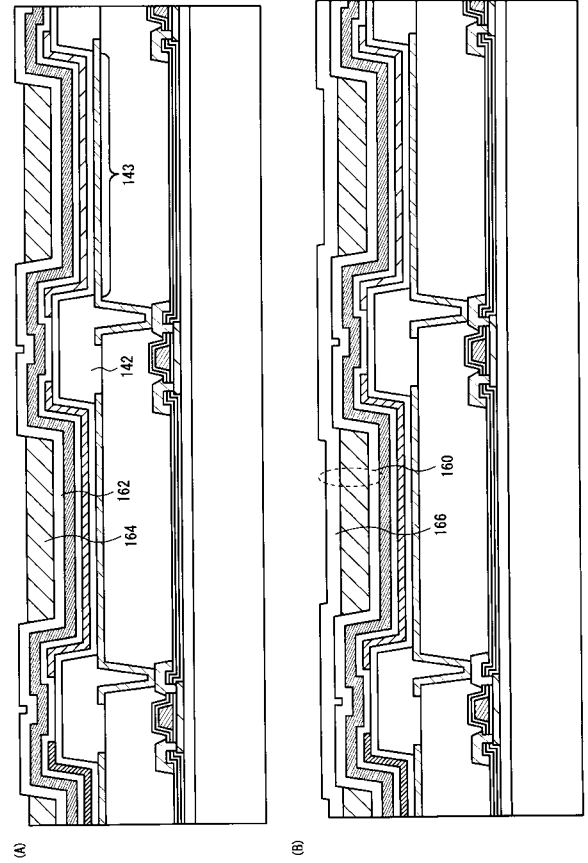
【図 4】



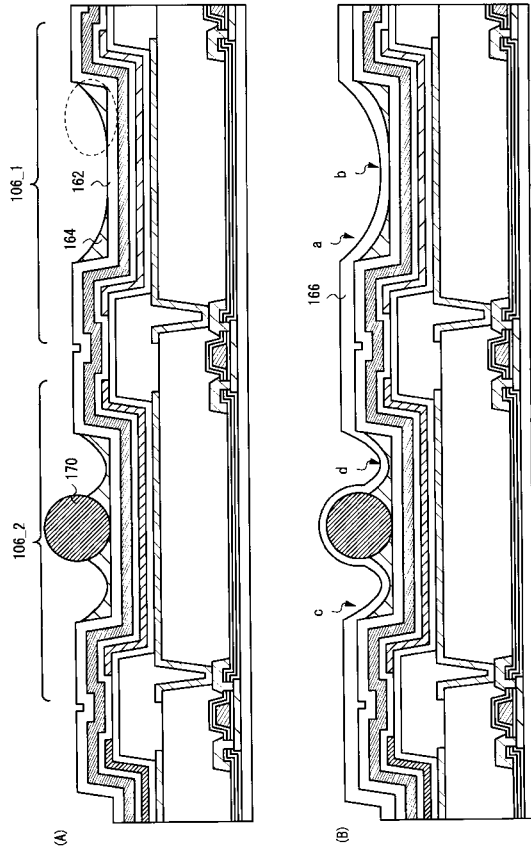
【図 5】



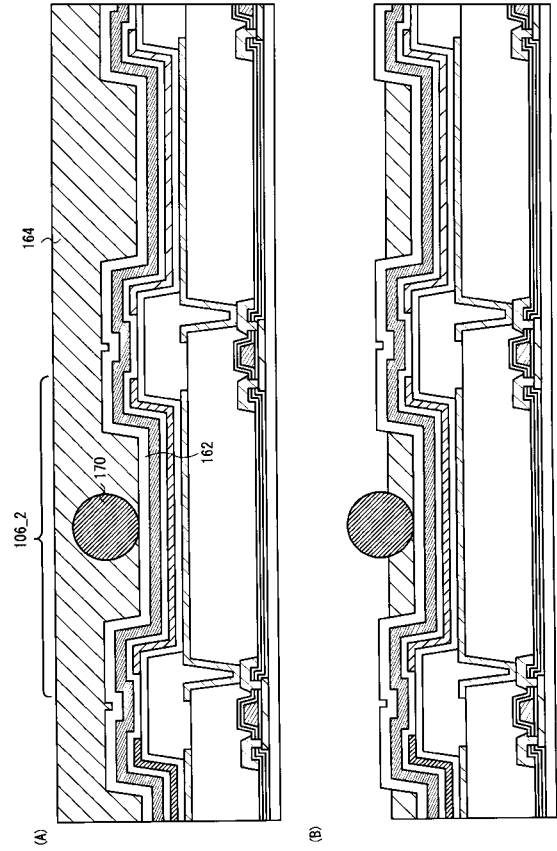
【図 6】



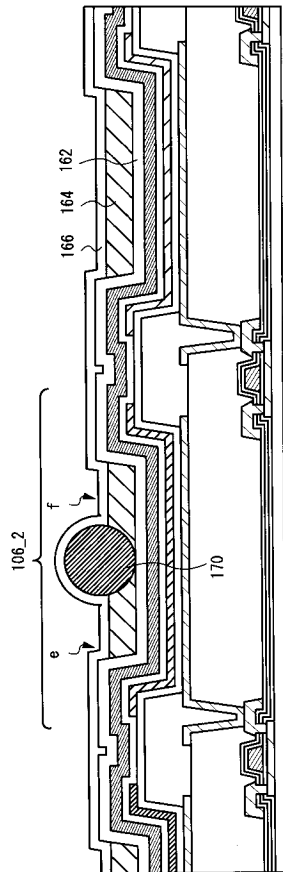
【図 7】



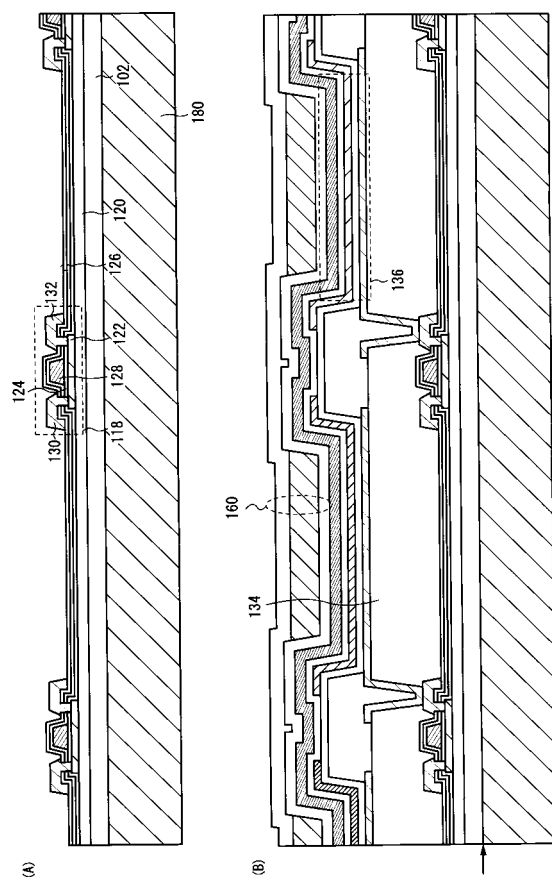
【図 8】



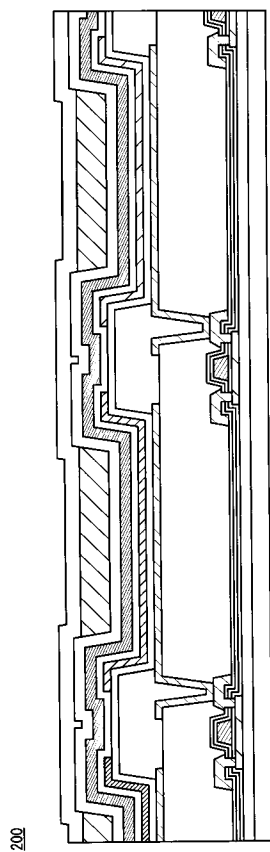
【図 9】



【図 10】



【図 11】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

H05B 33/02 (2006.01)

F I

H05B 33/02

テーマコード (参考)

专利名称(译)	显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP2017152226A	公开(公告)日	2017-08-31
申请号	JP2016033899	申请日	2016-02-25
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日本显示器		
申请(专利权)人(译)	有限公司日本显示器		
[标]发明人	神谷哲仙		
发明人	神谷 哲仙		
IPC分类号	H05B33/10 H01L51/50 H05B33/12 H05B33/22 H05B33/04 H05B33/02		
CPC分类号	H01L51/5253 H01L27/3211 H01L27/3244 H01L27/3246 H01L51/003 H01L51/56 H01L2227/323 H01L2227/326 H01L2251/301 H01L2251/303 H01L2251/5338 H01L2251/558		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.Z H05B33/04 H05B33/02 G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC43 3K107/DD16 3K107/DD17 3K107/DD89 3K107/EE48 3K107/EE49 3K107/EE50 3K107/FF15 3K107/GG28		
其他公开文献	JP6486848B2 JP2017152226A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种具有高显示质量的显示装置及其制造方法。形成覆盖第一电极端部的绝缘膜;在第一电极和绝缘膜上形成EL层;在EL层上形成EL层;在第二电极上形成含无机化合物的第一层162,在第二电极上形成含有机化合物的第二层164,以便与绝缘膜重叠,并在EL层上形成EL层。如图1所示,减薄第二层,使得第一层在与绝缘膜重叠的区域中暴露,并且在第二层上形成包含有机化合物的第三层166从而形成显示装置。 .The

